

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 04-002967
 (43)Date of publication of application : 07.01.1992

(51)Int.Cl. G01P 5/12
 G01P 5/10

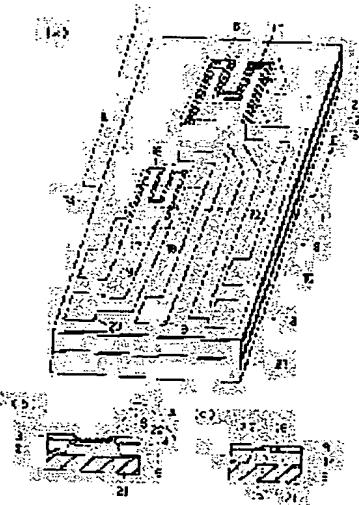
(21)Application number : 02-105616 (71)Applicant : MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD
 (22)Date of filing : 20.04.1990 (72)Inventor : NASA HARUHIKO
 FUKUDA KAZUYOSHI

(54) FLOW SENSOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve sensitivity and response speed by providing a semiconductor substrate, first to third thin film temperature measuring resistors and first and second cavities.

CONSTITUTION: First and second thin film temperature measuring resistors 6, 11 are formed on an insulating film 3 of a silicon substrate 1, while a first cavity 2 is formed on a region of the substrate 1 below the thin film temperature measuring resistors 6, 11. A third thin film temperature measuring resistor 16 is formed on a position separated from the thin film temperature measuring resistors 6, 11 while a second cavity 14 is formed on a region of the substrate 11 below the resistor 16. The cavities 2, 14 are made vacuum. If a flow sensor is placed in fluid, a resistance value of the resistor 6 constituting a flow speed sensing unit A increases/decreases according to change in temperature, so that voltage between electrode terminals 9, 10 increases/decreases. Since the resistor 6 is thus formed on the thin insulating film 3 integrally with the substrate 1 and the cavity 2 is made vacuum, the sensor is excellent in heat insulation and temperature of the resistor 6 can be easily raised even with a little power. In addition the cavities 2, 14 are sealed so that disturbance in the cavities can be prevented.



LEGAL STATUS

- [Date of request for examination]
- [Date of sending the examiner's decision of rejection]
- [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]
- [Date of final disposal for application]
- [Patent number]
- [Date of registration]
- [Number of appeal against examiner's decision of rejection]
- [Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
- [Date of extinction of right]

Copyright (C) 1998,2000 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY

⑯ 日本国特許庁 (JP)

⑯ 特許出願公開

⑯ 公開特許公報 (A)

平4-2967

⑤ Int. Cl. 5

G 01 P 5/12
5/10

識別記号

府内整理番号

⑯ 公開 平成4年(1992)1月7日

Z 7187-2F
7187-2F

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

④ 発明の名称 フローセンサ

② 特願 平2-105616

② 出願 平2(1990)4月20日

⑦ 発明者 系 佐 晴 彦 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

⑦ 発明者 福 田 和 良 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

⑦ 出願人 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地

⑦ 代理人 弁理士 宮 井 嘉夫

明細書

1. 発明の名称

フローセンサ

2. 特許請求の範囲

(1) 絶縁膜が表面に形成され絶縁基板が裏面に貼着された半導体基板と、この半導体基板の絶縁膜上に形成された第1および第2の薄膜測温抵抗体と、この第1および第2の薄膜測温抵抗体の下方における前記半導体基板の領域に形成した第1の空洞部と、前記半導体基板の絶縁膜上の前記第1および第2の薄膜測温抵抗体と別の位置に形成された第3の薄膜測温抵抗体と、この第3の薄膜測温抵抗体の下方における前記半導体基板の領域に形成した第2の空洞部とを備え、第1および第2の空洞部を真空にしたフローセンサ。

(2) 第1および第2の空洞部を共通の空洞部が形成したことを特徴とする請求項(1)記載のフローセンサ。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は、気体の流速や、さらにはそれから気体の流量を求めるために使用されるフローセンサに関するものである。

〔従来の技術〕

近年、計測用または基幹用にフローセンサが利用されるようになってきた。流速を計測する方法については、これまで各種類が発表されているが、その中でも発熱体の抵抗値が気体の流速により変化することを利用して、流速を計測する方法が計測器などで具体化されている。

フローセンサには、定電流型と定温度型とがあるが、いずれもその出力電圧 V または出力電流 I は、流速を v としたとき、

$$V \text{ または } I \propto (\alpha + \beta \times v^{1/2})^{-1/2}$$

となる関係がある。なお、 α 、 β は定数である。

この原理に基づいた定温度型のフローセンサの一例を第3図に示す。

第3図(1)はセンサ素子24を示す図である。センサ素子24は、短く長いガラス薄板25の同一面状の一方の端部側にヒーター26およびヒーター

温度センサ 2-8 が配置され、他方の端部側に温度センサ 2-7 が配置されているものである。これらヒータ 2-6、温度センサ 2-7 およびヒータ温度センサ 2-8 は、いずれも白金薄膜で構成されている。センサ基子 2-4 は、第 3 図例に示すように、ガラス薄板 2-5 の温度センサ 2-7 が配置されている側端部で、片持ち梁状にベース 2-9 により保持されている。

このフローセンサは、温度センサ 2-7 とヒータ温度センサ 2-8 とで検出される温度の差を一定に保つ回路に接続され、第 3 図例に示す矢印 2-1 方向へ気体を流すとともに、ヒータ 2-6 に通電し、温度センサ 2-7 とヒータ温度センサ 2-8 とによる検出温度差を一定に保持させたときのヒータ 2-6 の消費電力から流速を求めている。

〔発明が解決しようとする課題〕

フローセンサの特性は、主に流速に対する感度と応答速度とで評価されるが、上記従来のフローセンサは、感度と応答速度とを高めるためにセンサ基子 2-4 を実質的に中空に浮かせた状態になっ

ている。このため、構造上不安定であり、歩留りも非常に悪いという問題がある。

この発明の目的は、上記従来の問題を解決し、特性の優れたフローセンサを提供することである。

〔課題を解決するための手段〕

請求項 1 記載のフローセンサは、絶縁膜が表面に形成され複数基板が裏面に貼着された半導体基板と、この半導体基板の絶縁膜上に形成された第 1 および第 2 の薄膜測温抵抗体と、この第 1 および第 2 の薄膜測温抵抗体の下方における半導体基板の領域に形成した第 1 の空洞部と、半導体基板の絶縁膜上の第 1 および第 2 の薄膜測温抵抗体と別の位置に形成された第 3 の薄膜測温抵抗体と、この第 3 の薄膜測温抵抗体の下方における半導体基板の領域に形成した第 2 の空洞部とを備え、第 1 および第 2 の空洞部を真空にしている。

請求項 2 記載のフローセンサは、請求項 1 記載のフローセンサにおいて、第 1 および第 2 の空洞部を共通の空洞部で形成したことを特徴とする。

〔作用〕

この発明の構成によれば、半導体基板と一体の薄い絶縁膜上に第 1 の薄膜測温抵抗体が形成されしかも空洞部を真空にしてあるため断熱性に優れ、第 2 の薄膜測温抵抗体がかかる電力を容易に温度上昇する。また、空洞部が密閉され空洞部での乱流を防止できる。

〔実施例〕

実施例 1

この発明の第 1 の実施例のフローセンサについて第 1 図を参照しながら説明する。

第 1 図例はこの発明の第 1 の実施例の定電流型のフローセンサの斜視図、第 1 図例は第 1 図例において「1」線上に沿った断面図、第 1 図例は第 1 図例において「2」線上に沿った断面図である。

1 はシリコン基板、2 はシリコン基板 1 を異方性エッチャングして形成した第 1 の空洞部、3、5 は SiN_x または SiO_x からなる絶縁膜、4 は第 1 の空洞部 2 を異方性エッチャング形成する際に残留させた第 1 の空洞部 2 上の絶縁膜 3 からなる支持薄膜、6 は白金からなる第 1 の薄膜測温抵抗体

で支持薄膜 4 上のアクリル板 5 が形成されており、その端部部分はリード端子 7、8 にまでて電極端子 9、10 に接続されている。1 は白金からなる第 2 の薄膜測温抵抗体を支持薄膜 4 上に第 1 の薄膜測温抵抗体の逆勢にラグダグ状に形成されており、その両端部分はリード端子 7、12 によって電極端子 9、13 に接続されている。

14 はシリコン基板 1 を異方性エッチャングして形成した第 2 の空洞部、15 は第 2 の空洞部 14 を異方性エッチャング形成する際に残留させた第 2 の空洞部 14 上の絶縁膜 3 からなる支持薄膜、16 は白金からなる第 3 の薄膜測温抵抗体で支持薄膜 15 上にラグダグ状に形成されており、その両端部分はリード端子 7、18 によって電極端子 13、20 に接続されている。

21 は第 1 の空洞部 2 もしくは第 2 の空洞部が真空状態になるようにシリコン基板 1 に静電接着等で貼り合せた耐熱ガラス、22 は Si₃N₄ または SiO_x からなる保護膜である。

第 1 の空洞部 2 上の支持薄膜 4、第 1 の薄膜測

温度抵抗体 6、第 2 の薄膜測温抵抗体 11 および保護膜 22 からなる積層部分は、流速感応部 A を構成しその厚さは数 μ m から数十 μ m という極めて薄い膜状をなしている。

以下、この実施例のフローセンサの動作について説明する。

第 1 図において、流速感応部 A の構成要素である第 1 の薄膜測温抵抗体 6 は、電極端子 9、10 間に電圧を印加して通電すると発熱する。流速感応部 A は薄膜状であるので、僅かな電力で温度が上昇し、シリコン基板 1 の温度より高くなる。この流速感応部 A の温度変化に応じて、第 1 の薄膜測温抵抗体 6 の抵抗値が変化する。それに伴い電極端子 9、10 間の電圧が変化する。

この実施例のフローセンサを測定すべき液体中に置くとその流速に応じて流速感応部 A からの単位時間当たりの熱散逸量が変化する。すなわち、流速が増減することにより、流速感応部 A の温度が上昇または低下する。そして流速感応部 A を構成する第 1 の薄膜測温抵抗体 6 の抵抗値は温度の

変化に応じて増減するので、電極端子 9、10 間の電圧が増減する。

一方、シリコン基板 1 の温度または周囲温度は、第 3 の薄膜測温抵抗体 16 で検出される。無風状態で検出される温度と、第 1 の薄膜測温抵抗体 6 による温度との差が常に一定に保たれるように、第 2 の薄膜測温抵抗体 11 に一定流速を流しておく。このときの第 1 の薄膜測温抵抗体 6 の電圧を基準とすると、出力電圧 V または出力電流 I は、流速 v としたとき、

$V = V_0 (1 + \beta v^{1/2})^{1/2}$
となる関係式 (β は定数) から明らかのように、流速 v の値の 4 桟根に比例した出力電圧 V が得られる。

以上のようにこの実施例によれば、シリコン基板 1 上に異方性エッチングによって熱的に敏感な支持薄膜 4 と支持薄膜 15 を形成し、支持薄膜 4 の上に第 1、第 2 の薄膜測温抵抗体 6、11 を形成し、支持薄膜 15 の上に第 3 の薄膜測温抵抗体 16 を形成することにより、感度が高く、応答速

7

8

度の速い高精度なフローセンサが得られる。

実施例 2

この発明の第 2 の実施例のフローセンサについて第 2 図を参考しながら説明する。

第 2 図はこの発明の第 2 の実施例の直視図、第 2 図は第 2 図において直角に線に沿った断面図である。なお、第 1 図に対応するものには同一の符号を付してある。

この実施例では第 1 の実施例における 2 つの空洞部 2、14 を 1 つの空洞部 2a としたことに特徴がある。第 2 図に示すように、空洞部 2a の領域の絶縁膜 3 からなる支持薄膜 4a 上に、第 1、第 2 の薄膜測温抵抗体 6、11 を設け、その近傍に第 3 の薄膜測温抵抗体 16 を設けている。

空洞部 2a 上の支持薄膜 4a、第 1 の薄膜測温抵抗体 6、第 2 の薄膜測温抵抗体 11 および保護膜 22 からなる積層部分は、流速感応部 B を構成しその厚さは数 μ m から数十 μ m という極めて薄い膜状をなしている。

以下、この実施例のフローセンサの動作について説明する。

第 2 の薄膜測温抵抗体 11 を検出した第 1 の薄膜測温抵抗体 6 の温度と、第 3 の薄膜測温抵抗体 16 で検出したシリコン基板 1 の温度との差が常に一定に保たれるように第 1 の薄膜測温抵抗体 6 の電流源を制御する。

流速感応部 B から散逸する熱は流速の平方根に比例し、その分だけ第 1 の薄膜測温抵抗体 6 に流す電流が増えて温度差が一定に保たれる。第 2 の薄膜測温抵抗体 11 と第 3 の薄膜測温抵抗体 16 による検出温度差を一定に保持させたときの第 1 の薄膜測温抵抗体 6 の消費電力から流速が求められる。

（発明の効果）

この発明のフローセンサは、半導体基板と一体の薄い絶縁膜上に第 1 の薄膜測温抵抗体が形成され、しかも空洞部を真空にしてあるため断熱性に優れ、第 1 の薄膜測温抵抗体が僅かな電力で容易に温度上昇するので、感度と応答速度がともに高

められる。また、空洞部が密閉され空洞部での乱流を防止できるため、装置を配流する方向性も必要なく、電力消費量が少なく、効率良く流体の流速を検出することができる。

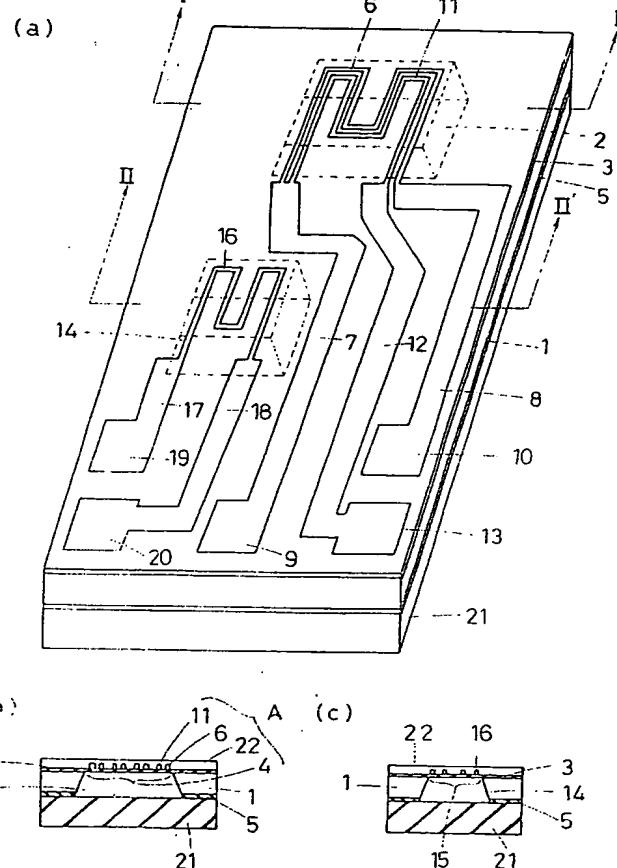
4. 図面の簡単な説明

第1図(1)はこの発明の第1の実施例のフローセンサの斜視図、第1図(2)は第1図(1)におけるⅠ-Ⅰ'線に沿った断面図、第1図(3)は第1図(1)におけるⅡ-Ⅱ'線に沿った断面図、第2図(1)はこの発明の第2の実施例のフローセンサの斜視図、第2図(2)は第2図(1)におけるⅢ-Ⅲ'線に沿った断面図、第3図(1)は従来のフローセンサにおける電子の平面図、第3図(2)は従来のフローセンサの斜視図である。

1…シリコン基板、2…第1の空洞部、2a…空洞部、3、5…掩蔽膜、4、4a、15…支持薄膜、6…第1の薄膜測温抵抗体、11…第2の薄膜測温抵抗体、14…第2の空洞部、16…第3の薄膜測温抵抗体、21…耐熱ガラス

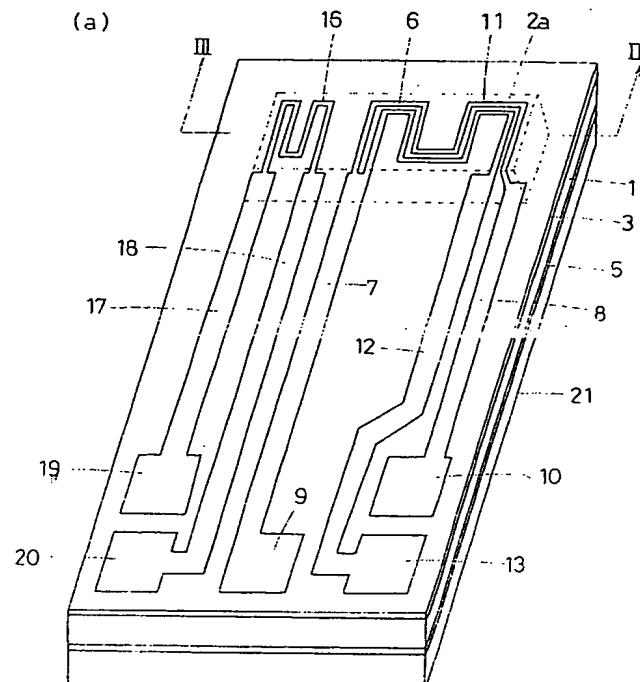
1 … リュン基板
 2 … 第 1 の空洞部
 3, 5 … 指紋膜
 4, 15 … 支持薄膜
 6 … 第 1 の薄膜測温抵抗体
 11 … 第 2 の薄膜測温抵抗体
 14 … 第 2 の空洞部
 16 … 第 3 の薄膜測温抵抗体
 21 … 駆熱ガラス

第 1 図

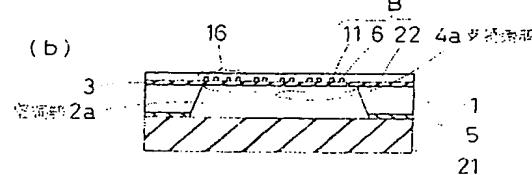


第 2 図

(a)

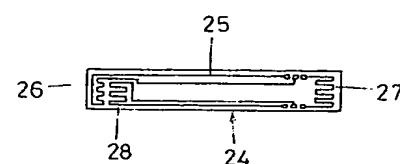


(b)



第 3 図

(a)



(b)

